

## 2SK2533

NチャンネルMOS形シリコン電解効果トランジスタ  
超高速スイッチング

## 暫定規格

- 特長
- ・低オン抵抗。
  - ・高速ダイオ - ド内蔵。
  - ・面実装に対応し、工数低減およびセットの高密度化、小型化が可能となる。

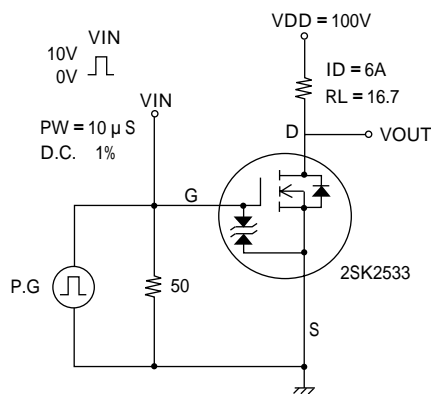
### 絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25

項目	記号	値	単位
ドレイン・ソース電圧	VDSS	250	V
ゲート・ソース電圧	VGSS	± 30	V
ドレイン電流 (DC)	ID	13	A
ドレイン電流 (パルス)	IDP PW 10 μs, duty cycle 1%	52	A
許容損失	PD Tc=25	45	W
チャンネル温度	Tch	150	
保存周囲温度	Tstg	- 55 ~ + 150	

### 電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25

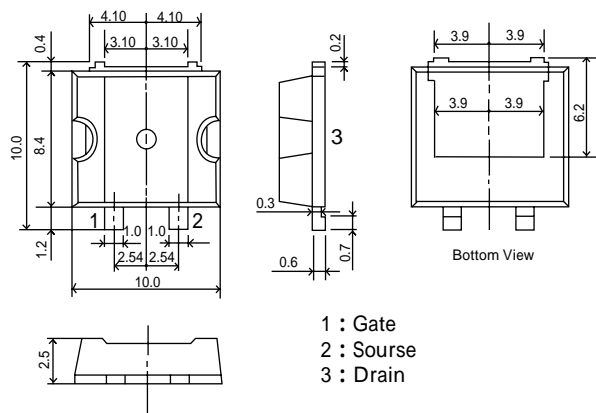
項目	記号	条件	min	typ	max	単位
ドレイン・ソース降伏電圧	V(BR)DSS	ID=1mA, VGS=0	250			V
ゲート・ソース降伏電圧	V(BR)GSS	IG= ± 100 μA, VGS=0	± 30			V
ドレイン・ソースシャ断電流	IDSS	VDS=250V, VGS=0			1.0	mA
ゲート・ソースもれ電流	IGSS	VGS= ± 25V, VDS=0			± 10	μA
ゲート・ソースシャ断電圧	VGS(off)	VDS=10V, ID=1mA	2.0		3.0	V
順伝達アドミタンス	yfs	VDS=10V, ID=6A	6.0	10		S
ドレイン・ソース間オン抵抗	RDS(on)	ID=6A, VGS=10V		200	270	m
入力容量	Ciss	VDS=20V, f=1MHz		1290		pF
出力容量	Coss	VDS=20V, f=1MHz		300		pF
帰還容量	Crss	VDS=20V, f=1MHz		125		pF
ターンオン遅延時間	td(on)	下図指定回路において		22		ns
立ち上がり時間	tr	"		66		ns
ターンオフ遅延時間	td(off)	"		320		ns
下降時間	tf	"		105		ns
ダイオード順電圧	VSD	IS = 12A, VGS = 0		1.0	1.5	V
ダイオード逆回復時間	trr	IS = 12A, di/dt=100A/μs		160		ns

### スイッチングタイム測定回路図



### 外形図

ZP(unit:mm)



これらの仕様は、改良などのため変更することがあります。